Streszczenie

Impulsowe przetapianie półprzewodnika podwyższa znacząco próg rozpuszczalności domieszek i daje szanse na uzyskanie materiału z pośrednim pasmem domieszkowym. Badania metodą RBS, PIXE i SIMS fosforku galu implantowanego tytanem pokazują, że wygrzewanie impulsowe wiązką elektronów prowadzi do otrzymania silnie domieszkowanej warstwy z odbudowaną doskonałą strukturą krystalograficzną.

Kolejnym problemem jest zbadanie właściwości elektrycznych takiej warstwy.